

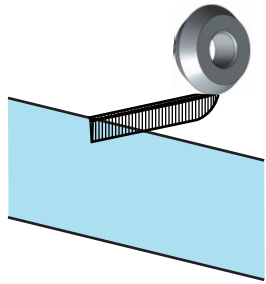
SiC ウェハの新切断加工

三星ダイヤモンド工業株式会社

「様々なガラスに対する高品質カッティング技術」を駆使し、「パワーデバイスで注目されている SiC ウェハ」に対応可能な加工プロセスおよび装置・工具を、お客様に提案します。

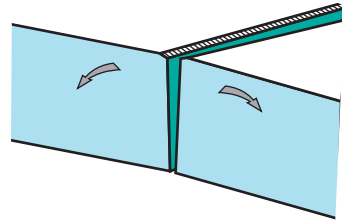
スクライブ+ブレイク法

●スクライブ工程



●分断に必要な垂直クラックを発生させる工程

■ブレイク工程



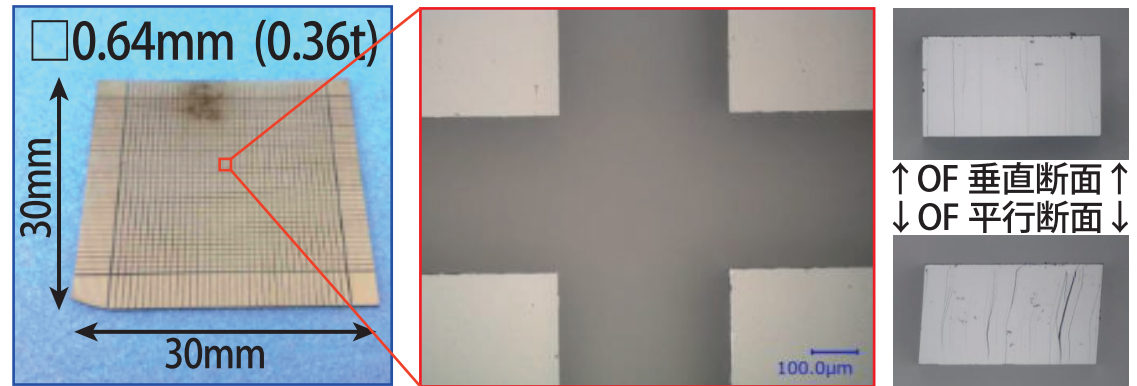
■曲げ応力により、垂直クラックを伸展させ完全分離する工程

スクライブ+ブレイク法の特徴

- ①加工速度が早い ⇒ 生産性向上
- ②カーフロスなし ⇒ 製品取り数アップ
- ③乾式加工 ⇒ 研削液不要

※SiC 切断プロセスとして海外で採用実績あり

SiC ウェハ切断事例



□1.0mm 以下も切断可能

切断加工法別の性能比較

加工法	小チップ化 (~□1mm)	工具 寿命	タクトタイム	品質	
				表裏 チッピング	断面
スクライブ + ブレイク	◎	◎	◎ (速度:100mm/s)	◎	○
ダイシング	○	○	○ (速度:3mm/s)	○	○

- お気軽にお問合せください TEL: 072-648-5004 (経営企画部)
- HP から受け付けております URL: <https://www.mitsuboshidiamond.com/>



MDI